

3CG130 型硅 PNP 高频小功率晶体管

1、特性

芯片采用硅外延平面结构，器件采用 A3-02B 型金属封装和 SMD-0.2、UA 型金属陶瓷封装。

器件具有特征频率高、体积小、重量轻，可靠性高的特点。

器件的静电放电敏感度为 4000V，A3-02B 典型重量 1.13g，SMD-0.2 典型重量 0.45g，UA 典型重量 0.12g。



注：SMD-0.2 封装产品型号后缀加“U”标识，UA 封装产品型号后缀加“UA”标识。

2、质量等级及执行标准

G、G+：QJ/01RBJ020H1-1999（A3-02B 型），Q/RBJ1001QZ（SMD-0.2、UA 型），QJZ840611；
 JP、JT、JCT（A3-02B 型）：ZZR-QJ/01RBJ021-1998，GJB33A-1997；
 JCT/K（A3-02B 型）：Q/RBJ22001-2003，GJB33A-1997；
 JCT/K（SMD-0.2 型）：Q/RBJ22028H1-2015，GJB33A-1997；
 JT、JCT、JY（A3-02B 型）：ZZR-Q/RBJ20075-2016，GJB33A-1997；
 CAST（A3-02B 型）：CASTPS10/151-2006，GJB33A-1997；
 SAST（A3-02B 型）：SASTYPS0202/0010-2015，GJB33A-1997；
 YA、YB、YC（A3-02B 型）：Q/QJA 20104/20-2017，Q/QJA 20104A-2017。

3、最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型 号	$P_{\text{tot1}}^{\text{a}}$ mW	$P_{\text{tot2}}^{\text{b}}$ mW	I_{CM} mA	V_{CBO} V	V_{CEO} V	V_{EBO} V	$T_{\text{stg}}, T_{\text{j}}$ °C
3CG130A	700	2000	300	-20	-15	-4	-55~175
3CG130B				-35	-30		
3CG130C				-50	-45		
3CG130D				-65	-60		
3CG130E				-80	-75		
$^{\text{a}}$ P_{tot1} 为 $T_{\text{A}}=25^{\circ}\text{C}$ ，不加散热片时的最大额定功率； $T_{\text{A}}>25^{\circ}\text{C}$ 时,按 $4.7\text{mW}/^{\circ}\text{C}$ 线性地降额。							
$^{\text{b}}$ P_{tot2} 为 $T_{\text{C}}=25^{\circ}\text{C}$ 时的最大额定功率； $T_{\text{C}}>25^{\circ}\text{C}$ 时,按 $13.3\text{mW}/^{\circ}\text{C}$ 线性地降额。							

4、主要电特性

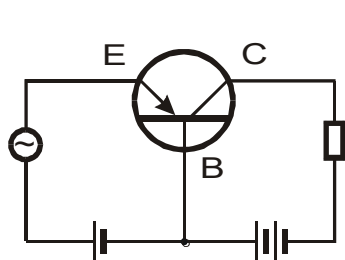
主要电特性（除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

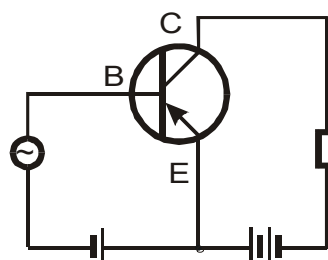
参 数		数 值			单 位
符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	
$V_{(BR)CBO}$	$I_C=0.1\text{mA}$	-20	—	—	V
$V_{(BR)CEO}$	$I_C=0.1\text{mA}$	-15	—	—	V
$V_{(BR)EBO}$	$I_E=0.1\text{mA}$	-4	—	—	V
I_{CBO}	$V_{CB}=-10\text{V}$	—	0.05	0.2	μA
I_{CEO}	$V_{CE}=-10\text{V}$	—	0.05	0.5	μA
I_{EBO}	$V_{EB}=-2\text{V}$	—	0.05	0.2	μA
h_{FE}	$V_{CE}=-10\text{V}, I_C=50\text{mA}$	25	—	—	—
$V_{BE(sat)}$	$I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}$	—	-0.8	-1.0	V
$V_{CE(sat)}$	$I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}$	—	-0.2	-0.6	V
f_T	$V_{CE}=-10\text{V}, I_C=50\text{mA}, f=30\text{MHz}$	80	200	—	MHz

5、典型电路应用图

器件在电子线路中主要有两种接线法，如图所示：

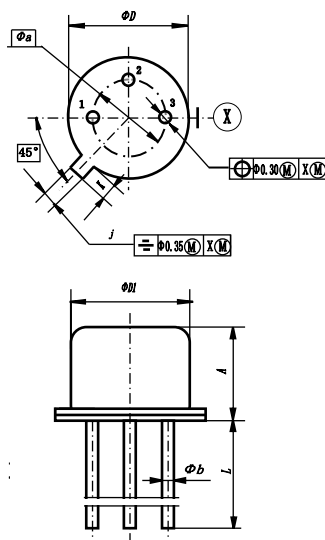


共基极接线法



共发射极接线法

6、外形尺寸



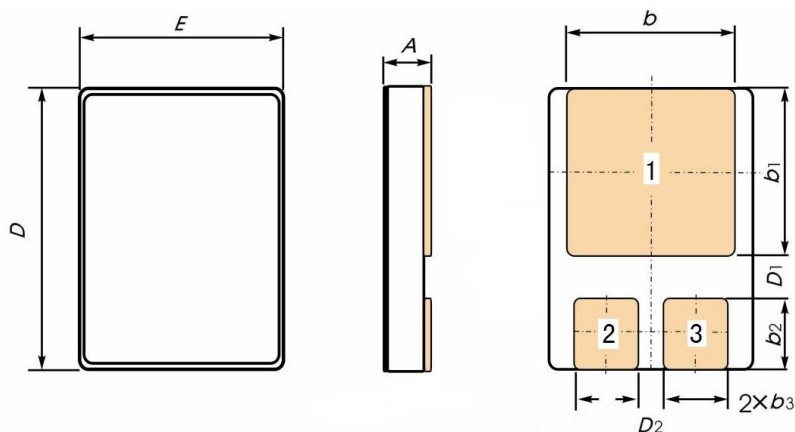
单位为毫米

尺寸符号	数 值		
	最 小	典型值	最 大
A	6.10	—	6.80
Φa	—	5.08	—
Φb	0.407	—	0.508
ΦD	8.64	—	9.39
ΦD_1	8.01	—	8.50
j	0.712	0.787	0.863
K	0.40	—	1.14
L	12.5	—	25.0

引出端极性：1—发射极，2—基极，3—集电极

A3-02B 外形尺寸

单位为毫米

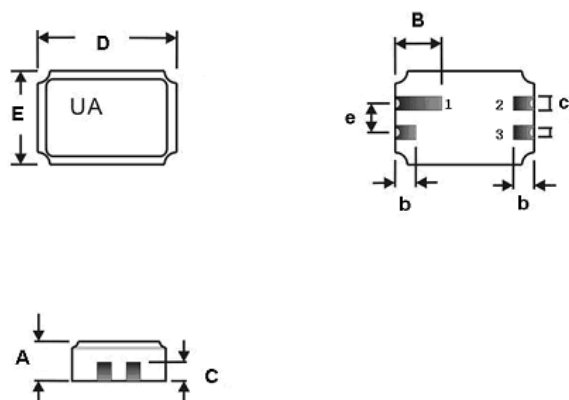


尺寸符号	数值	
	最 小 值	最 大 值
<i>A</i>	2.41	3.34
<i>b</i>	4.85	5.45
<i>b</i> ₁	4.40	5.15
<i>b</i> ₂	1.75	2.15
<i>b</i> ₃	1.85	2.25
<i>D</i>	7.77	8.13
<i>D</i> ₁	0.50	—
<i>D</i> ₂	0.60	—
<i>E</i>	5.23	5.64

引出端极性：1—集电极，2—发射极，3—基极

SMD-0.2 外形尺寸

单位为毫米



尺寸符号	数值	
	最小值	最大值
<i>A</i>	1.50	1.95
<i>B</i>	1.78	2.28
<i>b</i>	0.78	1.25
<i>C</i>	0.70	1.07
<i>c</i>	0.52	0.75
<i>D</i>	5.42	5.75
<i>E</i>	3.65	3.96
<i>e</i>	1.14	1.39

引出端极性：1—集电极，2—发射极，3—基极

UA 外形尺寸

7、使用和维护

7.1 器件的安装

安装质量的好坏对器件的可靠性影响很大。

A3-02B 型封装，引出端直径 0.407mm~0.508mm。在安装、测试等过程中不允许多次折弯和施应力，否则易造成引脚折断或玻璃绝缘子裂缝，影响其密封性。SMD-0.2、UA 型金属陶瓷封装，在安装、测试等过程中轻拿轻放，避免碰撞、重物碾压，否则易造成陶瓷金属裂缝，影响其密封性。

焊接安装时，器件允许耐焊接热的条件是温度 260℃ 下不超过 10 秒；浸锡温度不超过 260℃，时间不超过 10 秒。

7.2 器件的使用

测试或筛选时应严格按照规定条件、方法进行，应使用合格的设备、仪器仪表，并对其进行校验；操作人员必须持证上岗，必要时要进行专门培训。

严禁超规范使用，注意防潮、防尘，严禁裸手直接接触器件。

测试设备、仪器仪表可靠接地。

测试过程中应采取静电防护措施。

如发生不可预期情况或误操作造成器件损坏等情况，请与供应商联系。